

2SC3311, 2SC3311A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

低周波増幅用 / AF Amplifier

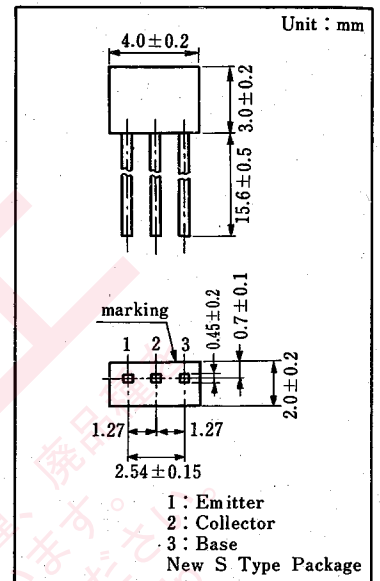
2SA1309, 2SA1309A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SA1309, 2SA1309A

■ 特徴 / Features

- 高密度実装に最適。 / Suitable for highly integrated mounting
- 縦形テーピングでの供給が可能。 / Supply by vertical taping is possible.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	30	V
2SC3311A		60	
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	25	V
2SC3311A		50	
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	200	mA
コレクタ電流	I _C	100	mA
コレクタ損失	P _C	300	mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =10 V, I _E =0			0.1	μA
	I _{CE0}	V _{CE} =10 V, I _B =0			1	μA
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	I _C =10 μA, I _E =0	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C =2 mA, I _B =0	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	I _E =10 μA, I _C =0	7			V
直流電流増幅率	h _{FE} *	V _{CE} =10 V, I _C =2 mA	160		460	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =50 mA, I _B =5 mA			0.3	V
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10 V, I _E =0, f=1 MHz		3.5		pF

*h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	Q	R	S
h _{FE}	160 ~ 260	210 ~ 340	290 ~ 460

